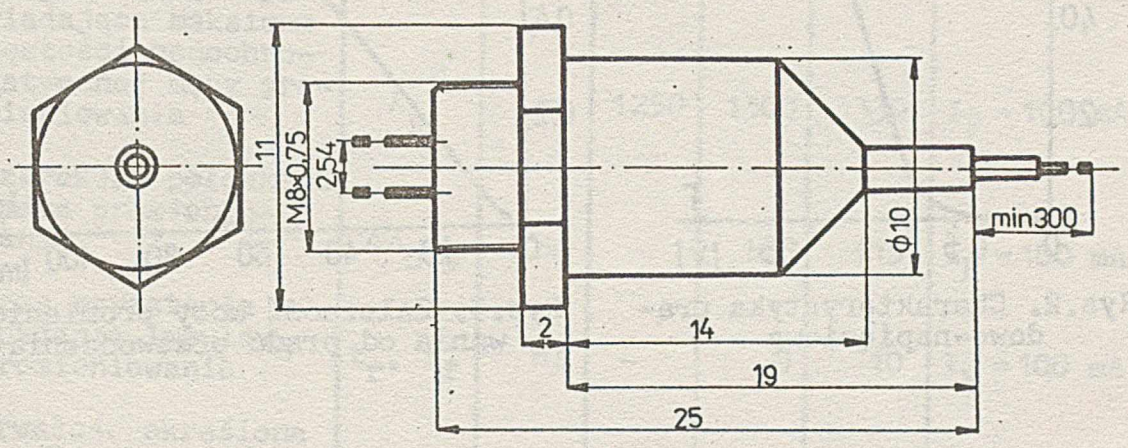
DIODA PODCZERWONA AQYP 10F

Dioda elektroluminescencyjna z GaInAs/InP wykonana techniką wielowarstwowej epitaksji jest przystosowana do połączenia ze światłowodem o aperturze numerycznej NA = 0,2 i średnicy rdzenia ϕ_r 50 μm. Może być stosowana w światłowodowych łączach telekomunikacyjnych średniego i dalekiego zasięgu.

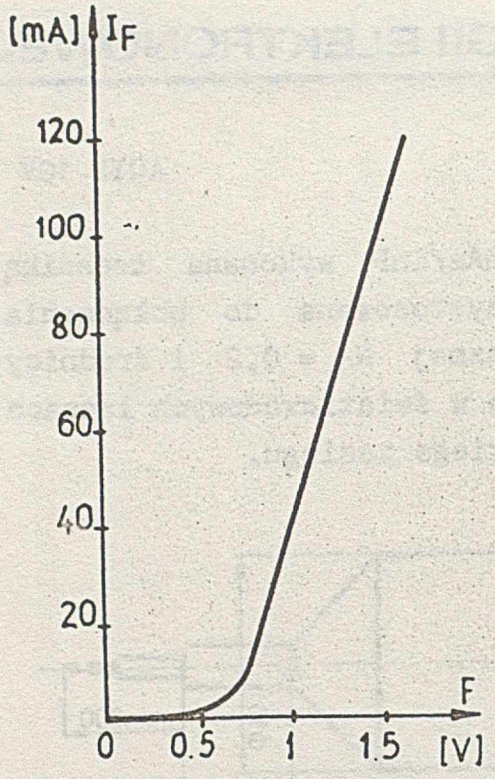


Rys. 1. Obudowa

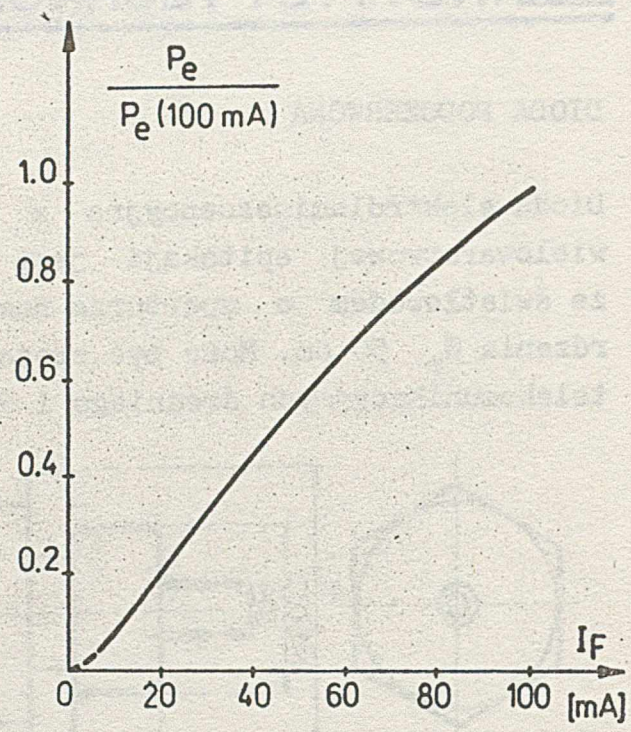
PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Natężenie prądu przewodzenia	I_F	100	mA
Napięcie wsteczne	U_R	2	V
Temperatura obudowy	t_{case}	-30 ÷ +50	°C
Temperatura przechowywania	t_{stg}	-40 ÷ +70	°C

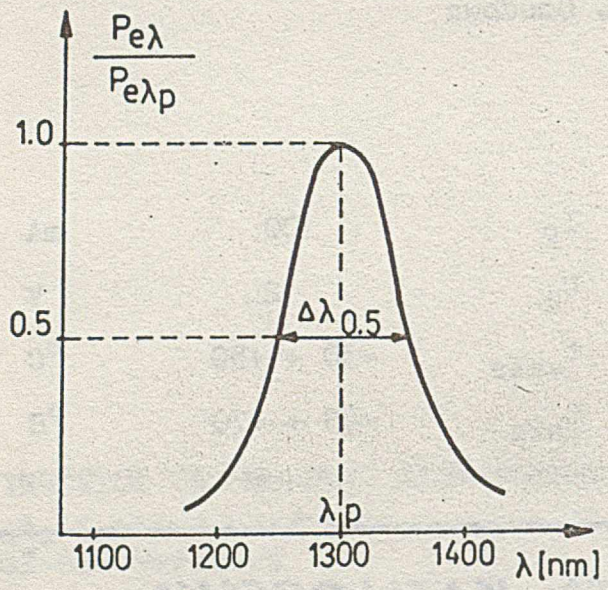
WSTĘPNA KARTA KATALOGOWA



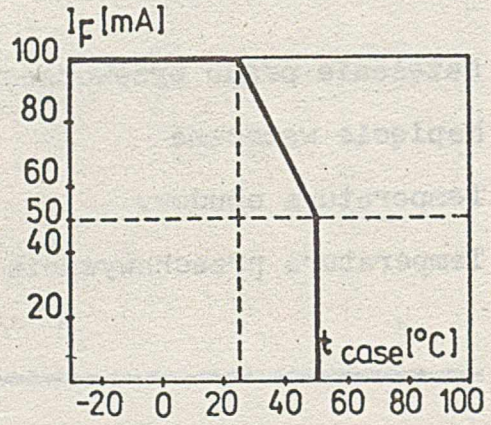
Rys.2. Charakterystyka prądowo-napięciowa



Rys.3. Zależność mocy promieniowania od prądu przewodzenia



Rys.4. Widmowy rozkład mocy promieniowania



Rys.5. Zależność dopuszczalnego prądu przewodzenia od temperatury

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru	Symbol	Jedn.	Wartość			Warunki pomiaru
			min.	typ.	max.	
Moc promieniowania	P_e	μW	10	12	-	I_F = 100 mA
Napięcie przewodzenia	U_F	V	-	-	2	I_F = 100 mA
Prąd wsteczny	I_B	μA	-	-	500	U_R = 2 V
Długość fali odpowiadająca maksimum gęstości monochromatycznej mocy promieniowania	λ_p	nm	1250	1300	1330	I_F = 100 mA
Szerokość połówkowa widma promieniowania	$\Delta\lambda_{0,5}$	nm	-	105	115	I_F = 100 mA
Czas narastania i opadania impulsu promieniowania	t_r, t_f	ns	-	9	10	I_F = 100 mA
Trwałość określona spadkiem mocy promieniowania do połowy wartości początkowej	$t_{1/2}$	h	10^4	-	-	I_F = 100 mA

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

tel. 43-54-01
tlx 815647

Lipiec 1987

Cena 40 zł

DRUK ZOINTE ITE zam. 70/87 n.300

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE